附件：

会议审定、预审、讨论和任务落实的标准项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 |
|  | 国标委发[2020]37号20202830-T-469 | 碳化硅单晶位错密度的测试方法 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2019]29号20193166-T-469 | 氮化镓单晶衬底片晶面曲率半径测试方法 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 预审 |
|  | 国标委发[2020]37号20202882-T-469 | 金属锗化学分析方法 第3部分:痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法 | 广东先导稀材股份有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科[2020]181号[2020-0719T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT07042020) | 高纯镓化学分析方法 第3部分：痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2020]37号20202918-T-469 | 氮化铝材料中痕量元素（镁、镓）含量及分布的测定 二次离子质谱法 | 北京科技大学、中国科学院半导体研究所 | 预审 |
|  | 国标委发[2020]53号20204893-T-469 | 碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法 | 芜湖启迪半导体有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2020]48号20203728-T-469 | 碳化硅外延片表面缺陷的测试 显微可见光法 | 芜湖启迪半导体有限公司 | 讨论 |
|  | 国标委发[2021]12号20210888-T-469 | 碳化硅抛光片表面质量和微管密度的测试 共焦点微分干涉法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 讨论 |
|  | 国标委发[2021]19号20211951-T-469 | 再生锗原料 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 任务落实 |
|  | 国标委发[2021]23号20213238-T-469 | 碳化硅晶体材料缺陷图谱 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 任务落实 |